

а 2020 0052

Изобретение относится к технологии производства наноструктурированных материалов, в частности к способам получения металлических наноструктурированных мембран.

Способ, согласно изобретению, включает осаждение тонкой пленки Au на полупроводниковую подложку и последующее травление подложки. При этом, пленка Au осаждается на подложку путем электрохимического осаждения в импульсном режиме, а травление подложки осуществляется путем анодирования.

П. формулы: 1

Фиг.: 3